



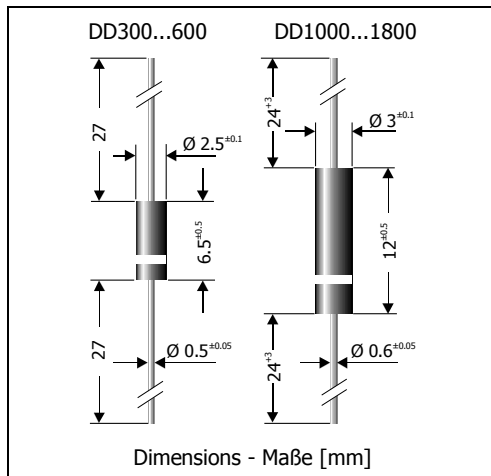
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

DD300 ... DD1800

Fast Switching High Voltage Silicon Rectifier Diodes Schnelle Silizium-Hochspannungs-Gleichrichterdioden

Version 2007-03-16



Nominal current Nennstrom	20 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	3 ... 18 kV
Plastic case Kunststoffgehäuse	DD300...DD600 Ø 2.5 x 6.5 [mm] DD1000...DD1800 Ø 3 x 12 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	DD300...DD600 0.3 g DD1000...DD1800 0.7 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	



Maximum ratings

Grenzwerte

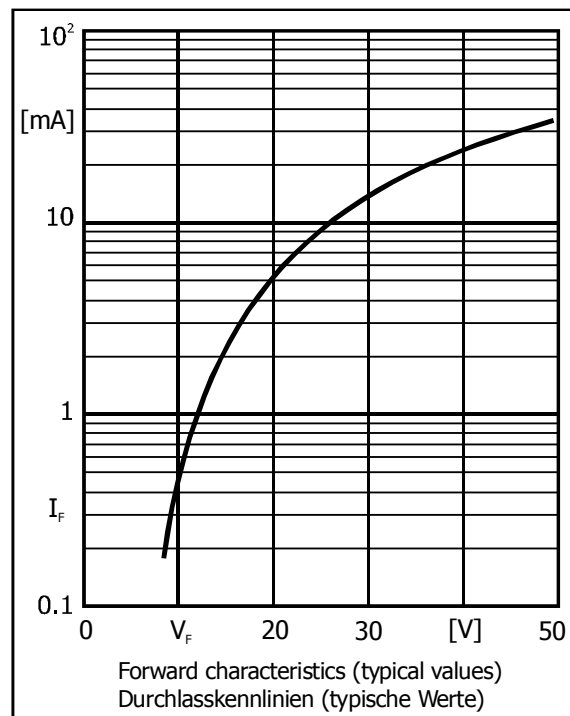
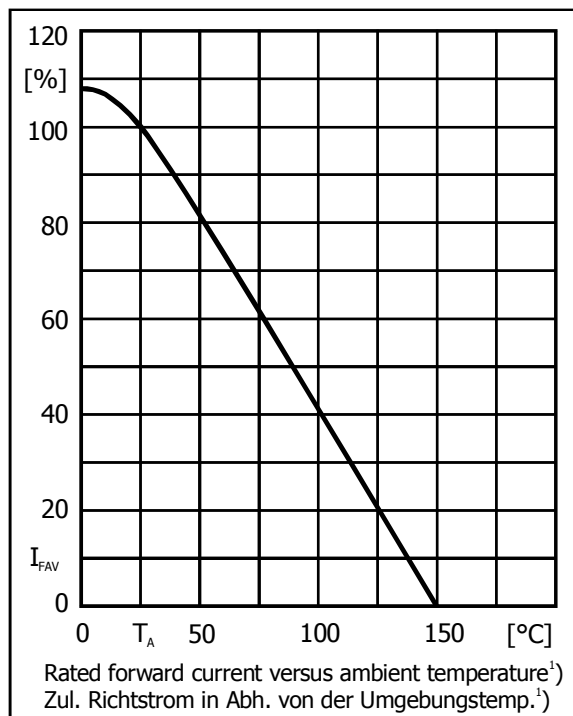
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DD300	3000	3000
DD600	6000	6000
DD1000	10000	10000
DD1200	12000	12000
DD1400	14000	14000
DD1600	16000	16000
DD1800	18000	18000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	300 mA ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	3 A ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10\text{ mA}$	V_F	$< 40\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 5\text{ }\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	$< 150\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 60\text{ K/W}^1)$



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden